

★電子デバイス研究会 (ED)

専門委員長 津田邦男 副委員長 須原理彦

幹事 新井 学・東脇正高 幹事補佐 大石敏之・岩田達哉

日時 10月26日(木) 13:30~17:10

27日(金) 9:30~12:05

会場 東北大学電気通信研究所本館6階大会議室(M601)(仙台市青葉区片平2-1-1. 地下鉄;五橋駅下車, 徒歩約8分. <http://www.riec.tohoku.ac.jp/ja/access/> TEL [022] 217-5571 佐藤信之)

議題 電子管と真空ナノエレクトロニクス及びその評価技術

26日

1. グラフェンを用いた低真空・低電圧で動作可能な高効率平面型電子放出デバイス
○村上勝久(産総研)・古家 遼(横浜国大)・飯島拓也(筑波大)・長尾昌善(産総研)・根本善弘・竹口雅樹(物材機構)・鷹尾祥典(横浜国大)・山田洋一・佐々木正洋(筑波大)
2. シリコンフィールドエミッタアレイからのレーザ支援電界電子放射特性
○嶋脇秀隆(八戸工大)・長尾昌善(産総研)・根尾陽一郎・三村秀典(静岡大)・高井幹夫(阪大)
3. ファウラーノルドハイムプロットの非直線性が切片傾き解析に及ぼす影響 後藤康仁(京大)
4. テラヘルツ波帯における真空デバイスへの取組み(その3)
○梶川恵広・吉田 満・宗廣孝継・増田則夫(NEC ネットワーク・センサ)・関根徳彦・菅野敦史・山本直克・笠松章史・寶迫 巖(NICT)
5. 300 GHz 帯 MEMS-FWG-TWT の設計検討(その3)
○葛木邦夫・根尾陽一郎・三村秀典(静岡大)・梶川恵広・増田則夫・吉田 満(NEC ネットワーク・センサ)
6. 単相全波倍圧整流回路を用いる位相制御マグネトロンの研究 ○楊 波・三谷友彦・篠原真毅(京大)
7. 炭化タングステン電界放射陰極の形成過程及び電子放出特性評価
○山梨遼太郎・根尾陽一郎・三村秀典(静岡大)
8. リン添加ダイヤモンド表面からの電子放出のエネルギー分析
○増澤智昭(静岡大)・岡野 健(国際基督教大)・根尾陽一郎・三村秀典(静岡大)・山田貴壽(産総研)

27日

1. 時間依存密度汎関数法によるカーボン系エミッタのフィールドエミッション電流の計算(第3報)
○樋口敏春・佐々木正洋・山田洋一(筑波大)
2. マルチエミッタ評価装置によるボルケーノ構造スピント型エミッタの動作チップの放出電流測定
田口広大・○村田英一・六田英治・下山 宏(名城大)・長尾昌善・村上勝久(産総研)
3. 高線量率のX線照射下におけるフィールドエミッタアレイの動作
○森藤瑛之・辻 博司(京大)・長尾昌善(産総研)・秋吉優史(阪府大)・高木郁二・後藤康仁(京大)
4. 微小電子源の作製技術を利用した超小型エレクトロスプレーラスターの試作
○村上勝久・長尾昌善(産総研)・井上直樹・鷹尾祥典(横浜国大)・クンプアン ソマワン・原 史朗(産総研/ミニマルファブ推進機構)
5. 高速パルス形成の為にアルカリ光電面に関する研究 ○吉武 亮・高橋隼斗・根尾陽一郎・三村秀典(静岡大)

◎26日研究会終了後, 懇親会を予定しておりますので御参加下さい。

☆ED研究会今後の予定 [] 内発表申込締切日

11月30日(木), 12月1日(金) 名工大〔締切済〕テーマ:窒化物半導体光・電子デバイス, 材料, 関連技術, 及び一般

2018年1月25日(木), 26日(金) 調整中〔未定〕テーマ:化合物半導体IC及び超高速・超高周波デバイス/マイクロ波一般

【発表申込先】 下記研究会発表申込システムからお申込み下さい。

<http://www.ieice.org/jpn/ken/kenmoushikomi.html>

【問合先】

新井 学(新日本無線)

TEL [049] 278-1441, FAX [049] 278-1269

E-mail: marai@njr.co.jp

東脇正高(NICT)

TEL [042] 327-6092, FAX [042] 327-5527

E-mail: mhigashi@nict.go.jp